

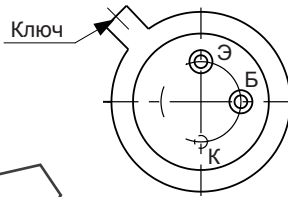
ДП КВАЗАР-ИС

ЭТИКЕТКА

Транзисторы:
2Т830А, 2Т830Б,
2Т830В, 2Т830Г.

Кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р транзисторы типов 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г в металлостеклянном корпусе КТ-2-7, предназначенные для работы в усилителях мощности, вторичных источниках питания, преобразователях и другой аппаратуре.

Схема расположения выводов



Масса не более 1,4 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25 °С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	Норма							
		2Т830А		2Т830Б		2Т830В		2Т830Г	
		не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кб} = 1 В, I_{к} = 1 А$)	$h_{21Э}$	25	-	25	-	25	-	20	-
Граничное напряжение, В ($I_{Э} = 100 мА, t_u \leq 300 мкс, Q > 100$)	$U_{кЭ0гр}$	25	-	45	-	60	-	80	-
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{кб} = 80 В$)	$I_{кЭР}$	-	100	-	100	-	100	-	100
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_{к} = 1 А, I_{Б} = 100 мА$)	$U_{кЭнас}$	-	0,6	-	0,6	-	0,6	-	0,6
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_{к} = 1 А, I_{Б} = 100 мА$)	$U_{БЭнас}$	-	1,3	-	1,3	-	1,3	-	1,3
Пробивное напряжение коллектор-база, В ($I_{к} = 100 мкА$)	$U_{кБ0проб}$	35	-	60	-	80	-	100	-
Пробивное напряжение эмиттер-база, В ($I_{Э} = 1 мА$)	$U_{ЭБ0проб}$	12	-	5	-	5	-	5	-
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером, МГц ($U_{кб} = 5 В, I_{Э} = 50 мА$)	$f_{гр}$	4	-	4	-	4	-	4	-

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 штук транзисторов

Содержание золота _____ г

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г соответствуют техническим условиям аА0.339.139 ТУ.

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для
штампа СК

Место для штампа "Перепроверка произведена _____" дата

Место для
штампа СК